

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 平野博茂 副委員長 大見俊一郎

幹事 森 貴洋・小林伸彰 幹事補佐 野田泰史・諏訪智之

日時 6月21日(火) 13:00~18:00

会場 名大・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (VBL) 3F ベンチャーホール (<http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html> 細井卓治 (関西学院大))

議題 MOS デバイス・メモリ・パワーデバイス高性能化—材料・プロセス技術 (応用物理学会シリコンテクノロジー分科会との合同開催)

1. [招待講演] 酸化膜/4H-SiC 界面特性に基づくカウンタードープ MOSFET の優位性  
○柴山茂久・土井拓馬・坂下満男・田岡紀之 (名大)・清水三聡 (産総研)・中塚 理 (名大)
2. 多層量子ドット構造実現に向けた絶縁体上への  $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$  ナノドットの自己形成  
○橋本 薫・柴山茂久・安坂幸師・中塚 理 (名大)
3. 金属 Hf の酸化によって形成した酸化物の結晶構造及び化学組成に Si 基板面方位が与える影響  
○安田 航・田岡紀之・大田晃生・牧原克典・宮崎誠一 (名大)
4. [依頼講演] オペランド・ナノ X 線分光を活用した次世代高周波デバイス研究 吹留博一 (東北大)
5. [依頼講演] TMD 混晶の物性と新規低温 CVD 原料の探索  
○小椋厚志・横川 凌 (明大/MREL)・若林 整 (東工大)
6. [依頼講演] 遷移金属カルコゲン化合物ヘテロ構造体の電子物性 丸山実那 (筑波大)
7. [招待講演] WSe<sub>2</sub> n/p FETs を用いた低電圧動作 CMOS インバータ  
○川那子高暢・松崎貴広・梶川亮介・宗田伊理也・星井拓也・角嶋邦之・筒井一生・若林 整 (東工大)
8. SiO<sub>2</sub> 上へのニッケルシリサイド薄膜形成とその表面形態・結晶相制御  
○木村圭佑・田岡紀之・大田晃生・牧原克典・宮崎誠一 (名大)
9. Si(111) 上の Al(111) 薄膜形成と熱処理による Si 原子の表面偏析制御  
○酒井大希・松下圭吾・大田晃生・田岡紀之・牧原克典・宮崎誠一 (名大)

◆応用物理学会共催

### 【問合先】

SDM 幹事: 森 貴洋 (産総研)

TEL [029] 849-1149

E-Mail: [mori-takahiro@aist.go.jp](mailto:mori-takahiro@aist.go.jp)